









	<h2 style="color: #E67E22;">GP1M013A050H</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	GP1M013A050H
	Hersteller / Marke:	Global Power Technologies Group
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 500V 13A TO220
Datenblätter:	 GP1M013A050H.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 2000 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	GP1M013A050H
Hersteller	Global Power Technologies Group
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 13A TO220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2000 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220
Verlustleistung (max)	183W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	480 mOhm @ 6.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	36nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1918pF @ 25V
Verpackung	Tube

GP1M013A050H ist neu im Original, Suche GP1M013A050H Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie GP1M013A050H Global Power Technologies Group mit Garantie und Vertrauen. Anfrage GP1M013A050H: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>GP1M016A025HG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 250V 16A TO220</p>	 <p>GP1M011A050H Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 11A TO220</p>	 <p>GP1M011A050HS Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 10A TO220</p>	 <p>GP1M013A050FH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 13A TO220F</p>
 <p>GP1M015A050H Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 14A TO220</p>	 <p>GP1M012A060FH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 12A TO220F</p>	 <p>GP1M016A025FG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 250V 16A TO220F</p>	 <p>GP1M012A060H Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 12A TO220</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ GP1FA551TZ	↔ GP1FA553RZ0F	⇒ GP1FA553RZ0F	D GP1FA553TZ0F	↔ GP1FAV31TK0F
⊥ GP1FAV50RK0F	⊗ GP1FAV50TK0F	D GP1FAV51TK0F	⇒ GP1FD320TP0F	↔ GP1FM313TMF5
⊗ GP1FM313TZMF	⊥ GP1FSV51TK0F	⊗ GP1L53VJ000F	↔ GP1L57J0000F	↔ GP1M003A050FG
D GP1M003A080CH	⊗ GP1M003A090C	⊥ GP1M006A070FH	⊗ GP1M007A090H	↔ GP1M008A025PG
⇒ GP1M009A020FG	↔ GP1M009A090N	⊗ GP1M010A060H	⊥ GP1M010A080FH	↔ GP1M011A050FH
↔ GP1M016A025CG	⇒ GP1M016A060F	D GP1M016A060H	⊗ GP1S092HCPI	⊥ GP1S092HCPIF
⊗ GP1S092HCPIF	D GP1S092HCPKF	⇒ GP1S093HCZ	↔ GP1S093HCZ0F	↔ GP1S093HCZ0F
⊥ GP1S093HCZ0F	⊗ GP1S094HCZ0F	↔ GP1S094HCZ0F	⇒ GP1S094HCZ0F	↔ GP1S096HCZ
⊗ GP1S096HCZ0F	⊥ GP1S096HCZ0F	⊗ GP1S097HCZ0F	D GP1S194HCZ0F	↔ GP1S194HCZ0F
↔ GP1S195HCPS4	⊗ GP1S195HCPSF	⊥ GP1S196HCCSF	⊗ GP1S196HCPSF	↔ GP1S196HCPSF

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited